Pressemitteilung

Nr. 591d



Pressemitteilungen

Download

**Neues Interferometer zur hochpräzisen Wafer-Dickenmessung**

**Das Weißlicht-Interferometer IMS5420-TH eröffnet neue Perspektiven in der industriellen Dickenmessung von monokristallinen Siliziumwafern. Dank der breitbandigen Superlumineszenzdiode (SLED) kann das IMS5420-TH sowohl für undotierte, dotierte sowie für hochdotierte SI-Wafer eingesetzt werden. Der Dickenmessbereich erstreckt sich von 0,05 bis zu 1,05 mm. Die messbare Dicke von Luftspalten beträgt sogar bis zu 4 mm.**

Bei der Produktion von Halbleiterwafern kommt es auf höchste Präzision an. Ein wichtiger Prozessschritt ist das Läppen der Siliziumrohlinge, die dabei auf eine einheitliche Dicke gebracht werden. Um die Dicke fortlaufend zu kontrollieren, wurden die Weißlichtinterferometer der Reihe interferoMETER IMS5420 entwickelt.

Diese bestehen jeweils aus einem kompakten Sensor und einem Controller, der in einem robusten industrietauglichen Gehäuse untergebracht ist. Eine im Controller integrierte aktive Temperaturregelung sorgt für eine hohe Stabilität der Messung.

Erhältlich ist das Interferometer entweder als Dicken- oder als Multipeak-Dickenmesssystem. Das Multipeak-Dickenmesssystem kann die Dicke von bis zu fünf Schichten messen, z.B. Waferdicke, Luftspalt, Folierung und Beschichtungen >50 µm. Für Dickenmessungen bei schwierigen Umweltbedingungen ist der Controller IMS5420IP67 mit IP67 und Edelstahlgehäuse sowie passenden Lichtleitern und Sensoren verfügbar.

Für Messaufgaben im Vakuum bietet Micro-Epsilon geeignete Sensoren,

Kabel und Durchführungen an.

ca. 1.500 Zeichen inkl. Leerzeichen



(interferoMETER\_IMS5420\_Waferdicke\_Pressefoto\_18x13.jpg)